

Document made available under the Patent Cooperation Treaty (PCT)

International application number: PCT/JP05/003751

International filing date: 04 March 2005 (04.03.2005)

Document type: Certified copy of priority document

Document details: Country/Office: JP
Number: 2004-061216
Filing date: 04 March 2004 (04.03.2004)

Date of receipt at the International Bureau: 28 April 2005 (28.04.2005)

Remark: Priority document submitted or transmitted to the International Bureau in compliance with Rule 17.1(a) or (b)



World Intellectual Property Organization (WIPO) - Geneva, Switzerland
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) - Genève, Suisse

PCT/JP 2005/003751

日 本 国 特 許 庁
JAPAN PATENT OFFICE

08. 3. 2005

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日
Date of Application: 2 0 0 4 年 3 月 4 日

出 願 番 号
Application Number: 特 願 2 0 0 4 - 0 6 1 2 1 6

パリ条約による外国への出願
に用いる優先権の主張の基礎
となる出願の国コードと出願
番号

The country code and number
of your priority application,
to be used for filing abroad
under the Paris Convention, is

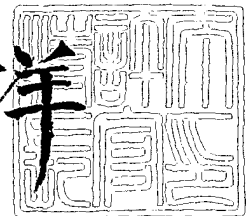
J P 2 0 0 4 - 0 6 1 2 1 6

出 願 人
Applicant(s): 浜松ホトニクス株式会社

2 0 0 5 年 4 月 1 4 日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

小 川 洋



出証番号 出証特 2 0 0 5 - 3 0 3 3 5 4 (

【書類名】 特許願
【整理番号】 2003-0332
【提出日】 平成16年 3月 4日
【あて先】 特許庁長官殿
【国際特許分類】 H01S 5/22
【発明者】
 【住所又は居所】 静岡県浜松市市野町 1 1 2 6 番地の 1 浜松ホトニクス株式会社
 内
 【氏名】 宮島 博文
【発明者】
 【住所又は居所】 静岡県浜松市市野町 1 1 2 6 番地の 1 浜松ホトニクス株式会社
 内
 【氏名】 渡邊 明佳
【発明者】
 【住所又は居所】 静岡県浜松市市野町 1 1 2 6 番地の 1 浜松ホトニクス株式会社
 内
 【氏名】 菅 博文
【特許出願人】
 【識別番号】 000236436
 【氏名又は名称】 浜松ホトニクス株式会社
【代理人】
 【識別番号】 100088155
 【弁理士】
 【氏名又は名称】 長谷川 芳樹
【選任した代理人】
 【識別番号】 100092657
 【弁理士】
 【氏名又は名称】 寺崎 史朗
【選任した代理人】
 【識別番号】 100124291
 【弁理士】
 【氏名又は名称】 石田 悟
【手数料の表示】
 【予納台帳番号】 014708
 【納付金額】 21,000円
【提出物件の目録】
 【物件名】 特許請求の範囲 1
 【物件名】 明細書 1
 【物件名】 図面 1
 【物件名】 要約書 1

【書類名】 特許請求の範囲

【請求項 1】

第 1 導電型クラッド層と、
第 2 導電型クラッド層と、
前記第 1 導電型クラッド層と前記第 2 導電型クラッド層との間に設けられた活性層と、
所定の軸方向に並んで設けられ、互いに対向する光出射面及び光反射面と
を備え、
前記第 1 導電型クラッド層が、前記活性層に屈折率型導波路を形成するリッジ部を有し

、
前記リッジ部が、前記屈折率型導波路の側面における全反射臨界角 θ_c に基づく角度で
前記所定の軸方向と交差する互いに対向する一対の側面を有することを特徴とする、半導
体レーザ素子。

【請求項 2】

前記光出射面と前記光反射面との間で共振する光が、前記リッジ部の前記一対の側面に
対応する前記屈折率型導波路の一対の側面のそれぞれにおいて同じ回数反射するように、
前記光出射面と前記光反射面との間隔及び前記リッジ部の前記一対の側面同士の間隔が設
定されていることを特徴とする、請求項 1 に記載の半導体レーザ素子。

【請求項 3】

前記リッジ部の前記光出射面側の端部及び前記光反射面側の端部のうち少なくとも一方
の端部における側面が、前記所定の軸方向に沿っていることを特徴とする、請求項 1 また
は 2 に記載の半導体レーザ素子。

【請求項 4】

前記リッジ部の前記一対の側面と前記所定の軸方向とのなす角 θ が、 $\theta_c - 1^\circ \leq \theta \leq$
 θ_c の範囲内であることを特徴とする、請求項 1 ～ 3 のいずれか一項に記載の半導体レー
ザ素子。

【請求項 5】

前記リッジ部の前記一対の側面と前記所定の軸方向とのなす角 θ が、前記全反射臨界角
 θ_c と略一致していることを特徴とする、請求項 1 ～ 4 のいずれか一項に記載の半導体レ
ーザ素子。

【請求項 6】

請求項 1 ～ 5 のいずれか一項に記載の半導体レーザ素子を複数備え、
前記複数の半導体レーザ素子が、前記リッジ部の長手方向と交差する方向に並んで配置
されて一体に形成されていることを特徴とする、半導体レーザ素子アレイ。

【書類名】明細書

【発明の名称】半導体レーザ素子及び半導体レーザ素子アレイ

【背景技術】

【0001】

従来より、半導体レーザ素子の構造として空間横シングルモード型とマルチモード型とが知られている。このうち、シングルモード型の半導体レーザ素子では、導波路内における発振モードを単一のモードのみに限定するために、導波路の幅が狭く形成される。しかし、導波路の幅が狭いと出射端の面積も小さくなる。また、出射端においてレーザ光密度が過大になると、半導体レーザ素子の信頼性等に影響する。従って、シングルモード型の半導体レーザ素子は、比較的低出力のレーザ光を用いる用途に好適に用いられる。なお、このシングルモード型の半導体レーザ素子の例としては、特許文献1に開示された半導体レーザ装置がある。この半導体レーザ装置は、シングルモード型の半導体レーザにおいて導波路の幅を拡張し、レーザ光強度を高めることを目的としている。

【0002】

他方、マルチモード型の半導体レーザ素子では、導波路内において複数のモードが混在してもよいと、導波路の幅を広く形成できる。従って、出射端の面積を大きくすることが可能となり、比較的大きな強度のレーザ光を出射することができる。このようなマルチモード型の半導体レーザ素子は、比較的高出力のレーザ光を必要とする用途に好適に用いられる。

【0003】

しかし、マルチモード型の半導体レーザ素子には、次のような問題がある。すなわち、導波路内において複数のモードが混在するため、出射端から出射されるレーザ光の出射パターンが乱れ出射角が比較的大きくなってしまふ。従って、このレーザ光を集光またはコリメートするためのレンズの形状が複雑となり、所望のレーザ光が得られなかったり、レンズが高価になるといった不利益を生じるおそれがある。

【0004】

上記したマルチモード型半導体レーザ素子の問題点を解決するための技術として、例えば特許文献2に開示された共振器がある。図16(a)は、この共振器の構成を示す平面図である。この共振器100は、活性層101内に2つの領域102a及び102bを有している。図16(b)は、図16(a)のIII-III断面及びIV-IV断面における屈折率分布を示す図である。図16(b)に示すとおり、領域102a及び102bにおける屈折率 n_2 は、活性層101の他の領域における屈折率 n_1 よりも小さく形成されている。また、領域102a及び102bは、出射端100a及び反射端100bにおいて垂直に反射した光Lが該領域102a及び102bの側面にて全反射する角度で活性層101内に形成されている。特許文献2では、このような構成によって、活性層101内を共振する光Lの光路を限定し、導波路幅を制限することなく単一モード発振を実現しようとしている。

【特許文献1】特開平10-41582号公報

【特許文献2】国際公開第00/48277号パンフレット

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0005】

しかしながら、特許文献2に開示された共振器には、以下の問題点がある。すなわち、この共振器の構成では活性層101に例えば溝を形成することによって領域102a及び102bを形成している。従って、活性層101内に領域102a及び102bのための溝と電流注入領域とを同時に作り込む必要があるため、構造が複雑となり、多くの工程を必要とする。また、活性層101への注入電流が導波路外に漏れ易い構造であるため、発光効率や電気・光変換効率が低く抑えられる。また、発光効率や電気・光変換効率の低さは、素子の温度上昇につながるため、素子の信頼性を損う、或いはレーザ光強度の向上を阻むといった不利益を生じることとなる。

【0006】

本発明は、上述の点を鑑みてなされたものであり、比較的大きな強度のレーザ光を出射可能であって、レーザ光の出射角が小さく、構成が単純であり、且つ効率のよい半導体レーザ素子及び半導体レーザ素子アレイを提供することを目的とする。

【課題を解決するための手段】

【0007】

上記課題を解決するために、本発明による半導体レーザ素子は、第1導電型クラッド層と、第2導電型クラッド層と、第1導電型クラッド層と第2導電型クラッド層との間に設けられた活性層と、所定の軸方向に並んで設けられ、互いに対向する光出射面及び光反射面とを備え、第1導電型クラッド層が、活性層に屈折率型導波路を形成するリッジ部を有し、リッジ部が、屈折率型導波路の側面における全反射臨界角 θ_c に基づく角度で所定の軸方向と交差する互いに対向する一対の側面を有することを特徴とする。

【0008】

上記半導体レーザ素子では、第1導電型クラッド層のリッジ部に電流が注入されることにより、リッジ部に対応する活性層の領域が活性領域となる。このとき、リッジ部とその外部との屈折率差によって、活性層には実効的な屈折率差が生じるため、リッジ部の平面視形状（リッジ部を第1導電型クラッド層の厚み方向から見た形状）に沿った形状の屈折率型導波路が形成される。また、このとき、リッジ部の一対の側面が屈折率型導波路の側面における全反射臨界角 θ_c に基づく角度で所定の軸方向と交差しているため、リッジ部の一対の側面に対応して形成される屈折率型導波路の一対の側面と所定の軸方向とのなす角が全反射臨界角 θ_c に基づいて定められる。これにより、光反射面において所定の軸方向に沿って反射した光は、屈折率型導波路の一方の側面において全反射し、他方の側面において再度全反射した後、所定の軸方向に沿って光出射面に達することとなる。光出射面において反射した光もまた、同様の光路を辿って光反射面に達する。他方、所定の軸方向と異なる方向に沿った光は、屈折率型導波路の側面を透過する。

【0009】

このように、上記半導体レーザ素子によれば、屈折率型導波路の構造上、共振が起こるレーザ光の光路を限定することができるため、導波路内でのレーザ発振に関わる光の角度成分が制限される。このため導波光の位相が揃って単一モード発振が生じ、さらに、出射されるレーザ光の水平方向の出射角は導波路幅の広がりに伴い小さくすることができる。また、シングルモード型のように屈折率型導波路の幅が制限されないため、より高い強度のレーザ光を出射することが可能となる。

【0010】

また、上記半導体レーザ素子では、容易に形成可能な第1導電型クラッド層のリッジ部によって、活性層に対して電流が部分的に集中して注入されるため、屈折率型導波路外に注入電流が漏れにくい。このため、上記半導体レーザ素子によれば、発光効率や電気・光変換効率を向上できる。また、これによって、素子の温度上昇を低減することができるので、素子の信頼性が向上するとともに、レーザ光強度を高めることが可能となる。

【0011】

また、半導体レーザ素子は、光出射面と光反射面との間で共振する光が、リッジ部の一対の側面に対応する屈折率型導波路の一対の側面のそれぞれにおいて同じ回数反射するように、光出射面と光反射面との間隔及びリッジ部の一対の側面同士の間隔が設定されていることを特徴してもよい。このように、共振する光が屈折率型導波路の一対の側面のそれぞれにおいて同じ回数反射（全反射）することによって、共振する光は光反射面及び光出射面の双方において所定の軸方向に沿って好適に入射／反射することができる。また、共振する光が屈折率型導波路の一対の側面において少なくとも1回ずつ全反射するので、屈折率型導波路内において光出射面と光反射面とを直線で結ぶような光路は存在しない。従って、この半導体レーザ素子によれば、屈折率型導波路内のレーザ光の光路を好適に制限することができる。

【0012】

また、半導体レーザ素子は、リッジ部の光出射面側の端部及び光反射面側の端部のうち少なくとも一方の端部における側面が、所定の軸方向に沿っていることを特徴としてもよい。これによって、光出射面、光反射面において所定の軸方向と異なる方向へ出射されるレーザ光を抑制することができる。

【0013】

また、半導体レーザ素子は、リッジ部の一対の側面と所定の軸方向とのなす角 θ が、 $\theta_c - 1^\circ \leq \theta \leq \theta_c$ の範囲内であることを特徴としてもよい。これによって、共振するレーザ光の光路を好適に限定することができるので、高次横モードを効果的に抑制することができる。

【0014】

また、半導体レーザ素子は、リッジ部の一対の側面と所定の軸方向とのなす角 θ が、全反射臨界角 θ_c と略一致していることを特徴としてもよい。これによって、高次横モードをほぼ完全に抑制することができる。

【0015】

また、本発明による半導体レーザ素子アレイは、上記したいずれかの半導体レーザ素子を複数備え、複数の半導体レーザ素子が、リッジ部の長手方向と交差する方向に並んで配置されて一体に形成されていることを特徴とする。

【0016】

上記半導体レーザ素子アレイによれば、上記したいずれかの半導体レーザ素子を備えることによって、比較的大きな強度のレーザ光を出射可能であって、レーザ光の水平方向の出射角が小さく、構成が単純であり、発光効率及び電気・光変換効率のよい半導体レーザ素子アレイを提供できる。

【0017】

さらに、上記半導体レーザ素子アレイでは、第1導電型クラッド層のリッジ部によって、活性層に対して電流が部分的に集中して注入されるので、隣り合う屈折率型導波路同士での光の結合や干渉が生じにくい。従って、各屈折率型導波路同士の間隔を比較的狭くすることが可能になるので、屈折率型導波路をより高密度に多く設けることができ、大出力で安定したレーザ光を出射することができる。

【発明の効果】

【0018】

本発明によれば、比較的大きな強度のレーザ光を出射可能であって、レーザ光の水平方向出射パターンが単峰性でレーザ光の出射角が小さく、構成が単純であり、且つ効率のよい半導体レーザ素子及び半導体レーザ素子アレイを提供できる。

【発明を実施するための最良の形態】

【0019】

以下、添付図面を参照しながら本発明による半導体レーザ素子及び半導体レーザ素子アレイの実施の形態を詳細に説明する。なお、図面の説明において同一の要素には同一の符号を付し、重複する説明を省略する。

【0020】

(第1の実施の形態)

図1は、本発明による半導体レーザ素子アレイの第1実施形態の構成を示す概略斜視図である。図1を参照すると、半導体レーザ素子アレイ1は、複数の半導体レーザ素子3が一体に形成されてなる。半導体レーザ素子アレイ1が備える半導体レーザ素子3の数は幾つでもよく、一つのみ備える場合はアレイではなく単体の半導体レーザ素子となる。半導体レーザ素子アレイ1は、互いに対向する光出射面1a及び光反射面1bを有しており、光出射面1a上には複数の半導体レーザ素子3それぞれのレーザ光出射端4aが水平方向に並んで配置されている。また、複数の半導体レーザ素子3のそれぞれは、リッジ状に成形された凸部25を有している。凸部25は、その長手方向が光出射面1a及び光反射面1bに対して斜めになるように設けられており、半導体レーザ素子3には凸部25に対応して屈折率型導波路(後述)が形成される。レーザ光出射端4aは、この屈折率型導波路

の光出射面 1 a 側の端面である。複数の半導体レーザ素子 3 は、凸部 2 5 の長手方向と交差する方向に並んで配置されて一体に形成されている。

【0021】

図 2 は、図 1 に示した半導体レーザ素子アレイ 1 の I-I 断面を示す拡大断面図である。図 2 を参照すると、半導体レーザ素子アレイ 1 を構成する半導体レーザ素子 3 は、基板 1 1 と、3 層の半導体層が積層された積層体 8 とを備えている。積層体 8 は、n 型クラッド層（第 2 導電型クラッド層）1 3、活性層 1 5、及び p 型クラッド層（第 1 導電型クラッド層）1 7 の 3 つの半導体層が順に積層されて構成されている。p 型クラッド層 1 7 にはリッジ部 9 が設けられている。リッジ部 9 の外側の層には p 型クラッド層 1 7 と電氣的に接続されるキャップ層 1 9 が設けられており、リッジ部 9 とキャップ層 1 9 とで凸部 2 5 を構成している。

【0022】

更に外側の層には外部からの電流を注入する p 側電極層 2 3 が設けられている。p 型クラッド層 1 7 及びキャップ層 1 9 と p 側電極層 2 3 との間には絶縁層 2 1 が設けられており、絶縁層 2 1 は凸部 2 5 に対応する部分に開口部 2 1 a を有している。p 側電極層 2 3 は開口部 2 1 a においてキャップ層 1 9 にのみ電氣的に接触するようになっているので、外部からの電流注入はキャップ層 1 9 にのみ限定してなされる。また、基板 1 1 の積層体 8 と反対側の面上には n 側電極層 2 9 が形成されている。基板 1 1 は n-GaAs からなる。n 型クラッド層 1 3 は n-AlGaAs からなり、活性層 1 5 は GaInAs/AlGaAs からなり、p 型クラッド層 1 7 は p-AlGaAs からなる。またキャップ層 1 9 は p-GaAs からなり、p 側電極層 2 3 は Ti/Pt/Au からなり、n 側電極層 2 9 は AuGe/Au からなり、絶縁層 2 1 は SiN からなる。

【0023】

キャップ層 1 9 に電流が注入されると、凸部 2 5 に対応する活性層 1 5 の領域（換言すれば、リッジ部 9 に対応する領域）が活性領域となる。このとき、リッジ部 9 とその外部との屈折率差によって、活性層 1 5 には実効的な屈折率差が生じるため、凸部 2 5 に対応する活性層 1 5 内に屈折率型導波路 4 が形成される。

【0024】

ここで、図 3 及び図 4 を参照して p 型クラッド層 1 7 について説明する。図 3 は p 型クラッド層 1 7 を含む積層体 8 の斜視図、図 4 (a) は積層体 8 の平面図、図 4 (b) は図 4 (a) に示した積層体 8 の II-II 断面を示す断面図である。上述のとおり、積層体 8 は、n 型クラッド層 1 3、活性層 1 5、及び p 型クラッド層 1 7 の 3 つの半導体層が順に積層されて構成されている。

【0025】

p 型クラッド層 1 7 には、光出射面 1 a と光反射面 1 b とにわたって延びる凸状のリッジ部 9 が設けられている。p 型クラッド層 1 7 のリッジ部 9 以外の領域は、層が薄化された薄肉領域 1 0 となっている。リッジ部 9 は、その平面視形状が、光出射面 1 a 及び光反射面 1 b と交差する所定の軸方向 A に対して角度 θ で交差する方向を長手方向とする平行四辺形となっている。

【0026】

リッジ部 9 は、第 1 端面 9 a、第 2 端面 9 b、並びに互いに対向する一対の側面 9 c 及び 9 d を有している。一対の側面 9 c 及び 9 d は、それぞれリッジ部 9 の領域を規定しており、リッジ部 9 と薄肉領域 1 0 との境界となっている。第 1 端面 9 a は、光出射面 1 a 上にある。第 2 端面 9 b は、光反射面 1 b 上にある。側面 9 c は第 1 端面 9 a の一端から第 2 端面 9 b の一端まで延び、側面 9 d は第 1 端面 9 a の他の一端から第 2 端面 9 b の他の一端まで延びている。側面 9 c 及び 9 d は、厚さ方向から見た平面図において所定の軸方向 A と角度 θ をなすように設けられている。

【0027】

活性層 1 5 にはリッジ部 9 の形状に対応した屈折率型導波路 4 が形成される。屈折率型導波路 4 は、リッジ部 9 への電流注入により生じる活性層 1 5 内部での実効的な屈折率分

布によって形成される導波路である。そして、屈折率型導波路 4 にはリッジ部 9 の第 1 端面 9 a に対応してレーザ光出射端 4 a が形成され、リッジ部 9 の側面 9 c、9 d それぞれに対応して一对の側面（後述）が形成される。リッジ部 9 における側面 9 c 及び 9 d と所定の軸方向 A とのなす角 θ は、屈折率型導波路 4 の側面における臨界角 θ_c に基づいて決定される。ここで、屈折率型導波路 4 の側面における臨界角 θ_c とは、屈折率型導波路 4 の内外の実効的な屈折率差によって規定される全反射臨界角である。後述するように、角 θ は、 $\theta_c - 1^\circ \leq \theta \leq \theta_c$ の範囲内であることが好ましく、さらには $\theta = \theta_c$ すなわち角 θ が臨界角 θ_c と略一致していることがより好ましい。角 θ が臨界角 θ_c に基づいて決定されることにより、屈折率型導波路 4 の一对の側面が、光出射面 1 a 側または光反射面 1 b 側から所定の軸方向 A に沿って入射する光を全反射させる。

【0028】

また、光出射面 1 a と光反射面 1 b との間隔（すなわち屈折率型導波路 4 の長さ）及びリッジ部 9 の一对の側面 9 c 及び 9 d 同士の間隔は、レーザ光出射端 4 a（光出射面 1 a）とレーザ光反射端 4 b（光反射面 1 b）との間で共振するレーザ光 L が、屈折率型導波路 4 の一对の側面 4 c 及び 4 d のそれぞれにおいて同じ回数反射するように設けられる。

【0029】

次に、半導体レーザ素子アレイ 1 の製造方法について図 5 を参照しながら説明する。図 5 は、各製造工程における半導体レーザ素子アレイ 1 の拡大断面図を示している。まず、n 型 GaAs の基板 11 を準備し、基板 11 上に順に、n 型 AlGaAs を $2.0\mu\text{m}$ 、GaInAs/AlGaAs を $0.3\mu\text{m}$ 、p 型 AlGaAs を $2.0\mu\text{m}$ 、p 型 GaAs を $0.1\mu\text{m}$ エピタキシャル成長させ、それぞれ n 型クラッド層 13、量子井戸構造を有する活性層 15、p 型クラッド層 17、キャップ層 19 を形成する（図 5（a）参照）。

【0030】

続いて、キャップ層 19 側にフォトリソによりリッジ部 9 に対応する形状に保護マスク 51 を形成し、キャップ層 19 及び p 型クラッド層 17 をエッチングする。エッチングは活性層 15 に達しない深さで停止する（図 5（b）参照）。続いて、SiN 膜を結晶表面全体に堆積し、フォトリソによりリッジ部 9 に対応する位置の SiN 膜を除去し、絶縁層 21 を形成する（図 5（c）参照）。続いて、Ti/Pt/Au 膜で p 側電極層 23 を結晶表面全体に形成する。また、基板 11 側の表面の研磨、化学処理を行い、AuGe/Au により n 側電極層 29 を形成する（図 5（d）参照）。

【0031】

次に、屈折率型導波路 4 内部におけるレーザ光の動きについて説明する。図 6 は、リッジ部 9 に対応して形成される屈折率型導波路 4 の形状を示す平面図である。屈折率型導波路 4 は、平面視形状がリッジ部 9 と同じ形状となる。屈折率型導波路 4 は、厚さ方向には活性層 15 と p 型クラッド層 17 との境界面、及び活性層 15 と n 型クラッド層 13 との境界面で規定される。屈折率型導波路 4 は、リッジ部 9 の第 1 端面 9 a 及び第 2 端面 9 b に対応する位置にそれぞれレーザ光出射端 4 a 及びレーザ光反射端 4 b を有している。レーザ光出射端 4 a 及びレーザ光反射端 4 b は、活性層 15 のへき開面の一部であり、レーザ光 L に対する共振面として機能する。

【0032】

また、屈折率型導波路 4 は、リッジ部 9 の側面 9 c 及び 9 d に対応する位置にそれぞれ側面 4 c 及び 4 d を有している。ここで、側面 4 c 及び 4 d は、屈折率型導波路 4 内外の屈折率差によって生じる面であり、屈折率が連続的に変化している場合にはそれぞれが或る一定の厚さを有してもよい。側面 4 c 及び 4 d は、屈折率型導波路 4 内で発生したレーザ光 L を当該側面への入射角度によって選択的に透過又は反射させる反射面として機能する。屈折率型導波路 4 の側面 4 c 及び 4 d と所定の軸方向 A とのなす角（すなわち、リッジ部 9 の側面 9 c 及び 9 d と所定の軸方向 A とのなす角） θ は、前述のとおり屈折率型導波路 4 の側面 4 c 及び 4 d における臨界角 θ_c に基づいて決定される。

【0033】

図6に示すように、レーザ光反射端4bにおいて所定の軸方向Aに沿って反射したレーザ光Lは、側面4cに角度 θ で入射し、全反射する。その後、レーザ光Lは側面4dに角度 θ で入射し、全反射する。こうして、側面4c及び4dで全反射したレーザ光Lは所定の軸方向Aに沿って進み、レーザ光出射端4aに達する。レーザ光出射端4aに達したレーザ光Lの一部は、レーザ光出射端4aを透過して外部へ出射される。また、他のレーザ光Lはレーザ光出射端4aにおいて所定の軸方向Aに沿って反射し、再び側面4d、4cで全反射してレーザ光反射端4bに戻る。このようにして、屈折率型導波路4内のレーザ光Lは、レーザ光出射端4aとレーザ光反射端4bとの間を往復し、共振することとなる。

【0034】

ここで、レーザ光Lが上記した光路に限定されるしくみについて説明する。図7は、側面4c(4d)に様々な入射角 θ_i で入射するレーザ光L1~L3について説明するための図である。なお、図7においては、説明の便宜のため、側面4c(4d)と所定の軸方向Aとのなす角 θ を臨界角 θ_c と一致させている。

【0035】

図7を参照すると、側面4c(4d)に角度 θ と等しい入射角 θ_i で入射したレーザ光L1は、側面4c(4d)において全反射し、レーザ光出射端4a(レーザ光反射端4b)に対し垂直に入射する。そして、レーザ光L1は、レーザ光出射端4a(レーザ光反射端4b)において反射したのち、同一の光路を辿って戻る。従って、レーザ光L1は同一光路上を共振することとなる。

【0036】

これに対し、側面4c(4d)に角度 θ よりも大きな入射角 θ_i で入射したレーザ光L2は、臨界角 θ_c を超えているので側面4c(4d)を透過することとなり、共振しない。また、側面4c(4d)に角度 θ よりも小さな入射角 θ_i で入射したレーザ光L3は、臨界角 θ_c を超えていないので側面4c(4d)において全反射するが、レーザ光出射端4a(レーザ光反射端4b)において反射した後、再度側面4c(4d)に入射する際に入射角が臨界角 θ_c を超えてしまう。従って、レーザ光L3も、結局側面4c(4d)を透過することとなり、共振しない。

【0037】

また、上述したように、リッジ部9の幅及び屈折率型導波路4の長さは、レーザ光Lが一对の側面4c及び4dのそれぞれにおいて同じ回数全反射するように設定されている。換言すれば、屈折率型導波路4は、レーザ光出射端4aとレーザ光反射端4bとの間で共振するレーザ光Lが、屈折率型導波路4の側面4c及び4dにおいて少なくとも1回は反射するように形成されている。従って、レーザ光出射端4aとレーザ光反射端4bとを直線で結ぶような光路は存在せず、レーザ光出射端4aとレーザ光反射端4bとの間を直接往復して共振する光は存在しない。

【0038】

上述のように、半導体レーザ素子3においては、屈折率型導波路4内で発生したレーザ光Lが往復して共振するための光路が、レーザ光出射端4a、側面4d、側面4c、及びレーザ光反射端4bを結ぶ光路に構造上限定されている。よって、所定の軸方向Aとほぼ平行な方向から側面4c、4dに入射し、上記の限定された光路で共振するレーザ光Lのみがレーザ発振に寄与することとなる。よって、空間横モードが単一であるレーザ発振(空間横シングルモード)が得られ、レーザ光出射端4aから出射されるレーザ光Lの強度分布は所定の軸方向Aと平行な方向付近に偏り、その出射パターンは単峰性となる。さらに、本導波路構造は広い導波路幅を持つことが可能であるが、レーザ放射角は導波路幅に反比例することから小さな出射角を持つレーザ光を得ることができる。

【0039】

屈折率型導波路4の側面4a、4bと所定の軸方向Aとのなす角 θ は、臨界角 θ_c とほぼ一致していることが最も望ましいが、臨界角 θ_c より小さい範囲で臨界角 θ_c に近づければ、レーザ光Lの光路をある程度限定することができる。ここで、図8は、角 θ の大きさ

が許容される範囲を説明するためのグラフである。図 8 において、横軸は角 θ の大きさであり、縦軸は側面 4 c (4 d) へのレーザ光 L の入射角 θ_i と角 θ との差 $\theta - \theta_i$ である。なお、ここでは、側面 4 c 及び 4 d の臨界角 θ_c を 4° と仮定して説明する。

【0040】

図 8 を参照すると、座標 $(\theta, \theta - \theta_i) = (0, 0)$ 、 $(4, 0)$ 、 $(0, 4)$ で囲まれる領域 B が図示されている。この領域 B は、レーザ光 L がレーザ光出射端 4 a とレーザ光反射端 4 b との間で共振することができる範囲を示している。例えば、角 θ が 1° のとき、 $0^\circ \leq \theta - \theta_i \leq 3^\circ$ 、すなわち入射角 θ_i が 1° 以上 4° 以下のレーザ光 L であれば、側面 4 c 及び 4 d において臨界角 $\theta_c (= 4^\circ)$ を超えることなく共振することができる。しかしながら、角 θ が臨界角 θ_c よりも過小であると、屈折率型導波路 4 内でのレーザ光 L の空間横モードの数が増えて出射角が拡大してしまう。従って、例えば角 θ を $1^\circ \leq \theta \leq 4^\circ$ (すなわち、 $\theta_c - 1 \leq \theta \leq \theta_c$) とすることにより、 $0^\circ \leq \theta - \theta_i \leq 3^\circ$ 、つまり入射角 θ_i が 3° 以上 4° 以下のレーザ光 L のみ共振することとなり、レーザ光 L の出射角を実用的な範囲まで小さくすることができる。

【0041】

本実施形態による半導体レーザ素子 3 が有する効果について説明する。半導体レーザ素子 3 によれば、共振が起こるレーザ光 L の光路を限定することができるため、レーザ発振する光の角度成分が制限され、高次横モードが抑制され単一モードに近くなり、出射されるレーザ光 L の水平方向の出射パターンを単峰性にするができる。また、シングルモード型のように屈折率型導波路 4 の幅すなわち側面 4 c と側面 4 d との間隔が制限されないで、レーザ光出射端 4 a におけるレーザ光密度を低減でき、より高い強度のレーザ光を出射することが可能となる。さらに、屈折率型導波路 4 の幅を広げるとレーザ光 L の水平方向の出射角を小さくすることができる。

【0042】

また、本実施形態の半導体レーザ素子 3 では、図 5 (a) ~ 図 5 (d) に示したように容易に形成可能なリッジ部 9 によって、活性層 15 に対して電流が部分的に集中して注入されるので、屈折率型導波路 4 の外部へ注入電流が漏れにくい。このため、半導体レーザ素子 3 によれば、発光効率や電気・光変換効率を向上できる。また、これによって、半導体レーザ素子 3 の温度上昇を低減することができるので、半導体レーザ素子 3 の信頼性が向上するとともに、レーザ光強度を高めることが可能となる。

【0043】

また、本実施形態のように、レーザ光出射端 4 a (光出射面 1 a) とレーザ光反射端 4 b (光反射面 1 b) との間で共振するレーザ光 L が、屈折率型導波路 4 の一対の側面 4 c 及び 4 d のそれぞれにおいて同じ回数反射するように、光出射面 1 a と光反射面 1 b との間隔 (すなわち屈折率型導波路 4 の長さ) 及びリッジ部 9 の一対の側面 9 c 及び 9 d 同士の間隔が設定されていることが好ましい。このように、レーザ光 L が一対の側面 4 c 及び 4 d のそれぞれにおいて同じ回数反射 (全反射) することによって、共振するレーザ光 L はレーザ光出射端 4 a 及びレーザ光反射端 4 b の双方において所定の軸方向 A に沿って好適に入射/反射することができる。また、このような構成により、レーザ光 L が一対の側面 4 c 及び 4 d において少なくとも 1 回ずつ全反射するので、屈折率型導波路 4 内においてレーザ光出射端 4 a とレーザ光反射端 4 b とを直線で結ぶような光路は存在しない。従って、本実施形態の半導体レーザ素子 3 によれば、屈折率型導波路 4 内のレーザ光 L の光路を好適に制限することができる。

【0044】

また、本実施形態による半導体レーザ素子アレイ 1 によれば、上記効果を有する半導体レーザ素子 3 を複数備えることによって、比較的大きな強度のレーザ光を出射することができるとともに、レーザ光 L の水平方向の出射角を小さくすることができる。また、半導体レーザ素子アレイ 1 によれば、簡易な構成によって発光効率及び電気・光変換効率を向上できる。

【0045】

さらに、本実施形態による半導体レーザ素子アレイ1は、次の効果を有する。すなわち、半導体レーザ素子アレイ1では、p型クラッド層17のリッジ部9によって、活性層15に対して電流が部分的に集中して注入される。これにより、隣り合う半導体レーザ素子3の屈折率型導波路4同士での光の結合や干渉が生じにくくなる。従って、各屈折率型導波路4同士の間隔を比較的狭くすることが可能になるので、屈折率型導波路4をより多く設けることができ、大出力で安定したレーザ光を出射することができる。さらに、活性層15に対して電流が部分的に集中して注入することにより、電気・光変換効率が高まり、無効電流を低減できるので、半導体レーザ素子3の熱発生を低減できる。従って、半導体レーザ素子アレイ1の信頼性が高まり、長寿命化を実現できる。

【0046】

(第1の実施例)

次に、上記した実施形態による単体の半導体レーザ素子3の実施例を説明する。本実施例では、屈折率型導波路4の側面4c及び4dと所定の軸方向Aとのなす角 θ を、屈折率型導波路4内外の屈折率差に基づく臨界角 4° とした。また、屈折率型導波路4の側面4cと側面4dとの間隔(すなわち屈折率型導波路4の幅)を $40\mu\text{m}$ とし、レーザ光出射端4aとレーザ光反射端4bとの間隔(すなわち屈折率型導波路4の長さ)を、図6に示したような光路を実現できる $1200\mu\text{m}$ とした。因みに、従来のシングルモード型半導体レーザ素子(特許文献1に開示されたものを含む)の導波路幅は、最大でも約 $5\mu\text{m}$ である。従って、上記実施形態に係る半導体レーザ素子3の屈折率型導波路4の幅が従来のシングルモード型半導体レーザ素子と比較して格段に大きいことがわかる。

【0047】

図9(a)は、本実施例による、半導体レーザ素子3の電流-光出力特性を示すグラフである。図9(a)によれば、半導体レーザ素子3に供給した電流とレーザ光出力とが直線的な相関関係を示しており、いわゆるキンクも生じていないので、半導体レーザ素子3においては安定した空間横シングルモードが得られ、スロープ効率は 0.75W/A である。また、図9(b)は、半導体レーザ素子3のレーザ光出射端4aから出射されたレーザ光の水平方向の遠視野像を示すグラフである。図9(b)に示すとおり、半導体レーザ素子3においては、レーザ光の遠視野像における強度分布が所定の軸方向(0°)に偏っており、水平方向の出射角が小さいことがわかる。図9(b)によれば、ピークの半値幅は 2° 程度となっている。

【0048】

また、比較例として、特許文献2に開示された共振器の特性を図10(a)及び図10(b)に示す。図10(a)は、この共振器の電流-光出力特性を示すグラフである。図10(a)によれば、レーザ光出力の上昇とともに空間横モードの変化に対応したレーザ光出力特性の乱れ(いわゆるキンク)が生じモードが不安定であり、このときのスロープ効率は 0.5W/A である。また、図10(b)は、この共振器から出射されたレーザ光の水平方向の遠視野像を示すグラフである。図10(b)によれば、メインピークの半値幅は 2° 程度である。

【0049】

このように、本実施例に係る半導体レーザ素子3によれば、特許文献2に開示された共振器と比較して、発光効率及び電気・光変換効率を向上できるとともに、高出力時においても安定した空間横シングルモード動作が可能となる。

【0050】

(第2の実施例)

次に、上記した実施形態による、複数の半導体レーザ素子3を備える半導体レーザ素子アレイ1の実施例について説明する。本実施例では、 $200\mu\text{m}$ のピッチで 1cm 内に50個のリッジ部9を形成した。図11(a)は、半導体レーザ素子アレイ1の電流-光出力特性を示すグラフである。図11(a)によれば、半導体レーザ素子アレイ1の各半導体レーザ素子3に供給した電流とレーザ光出力とが直線的な相関関係を示しており、いわゆるキンクも生じていない。また、このグラフから読みとれる素子のスロープ効率は 0.75W/A である。

75W/Aであり、単体の半導体レーザ素子3の場合と同等である。従って、レーザ光が導波路同士で結合及び干渉するおそれのある特許文献2の共振器と比較して、リッジ部9を備える半導体レーザ素子アレイ1の構造が優れているといえる。

【0051】

また、図11(b)は、本実施例に係る半導体レーザ素子アレイ1が備える各半導体レーザ素子3のレーザ光出射端4aから出射されたレーザ光Lの水平方向の遠視野像を示すグラフである。図11(b)に示すとおり、半導体レーザ素子アレイ1においては、レーザ光Lの遠視野像における強度分布が単体の半導体レーザ素子3における該強度分布(図9(b)参照)と同様であるので、アレイ化しても単体の素子と同様の特性が維持されていることがわかる。

【0052】

このように、本実施例に係る半導体レーザ素子アレイ1によれば、リッジ構造が活性層15への注入電流を集中させることにより、アレイ化したことによる屈折率型導波路4同士のレーザ光の結合、干渉等を好適に抑えることができる。

【0053】

(第2の実施の形態)

次に、本発明による半導体レーザ素子アレイ(半導体レーザ素子)の第2実施形態について説明する。図12は、本実施形態による半導体レーザ素子が有する屈折率型導波路41を示す平面図である。この屈折率型導波路41は、その平面形状が第1実施形態による屈折率型導波路4と異なる。すなわち、屈折率型導波路41は、4つの側面41c~41fを備えている。このうち、側面41cと側面41dとが互いに対向しており、側面41eと側面41fとが互いに対向している。側面41cの一端はレーザ光反射端41bの一端に接しており、側面41dの一端はレーザ光反射端41bの他端に接している。側面41cの他端は側面41eの一端に繋がっており、側面41dの他端は側面41fの一端に繋がっている。側面41eの他端はレーザ光出射端41aの一端に接しており、側面41fの他端はレーザ光出射端41aの他端に接している。側面41c~41fは、それぞれ所定の軸方向Aと角度 θ で交差している。側面41cと側面41eとは互いに角度 2θ をなして繋がっており、側面41dと側面41fとは互いに角度 2θ をなして繋がっている。本実施形態では、このような形状の屈折率型導波路41が、同様の平面形状を有するリッジ部をp型クラッド層が有することによって実現される。

【0054】

レーザ光反射端41bを所定の軸方向Aに沿って反射したレーザ光Lは、側面41cにおいて全反射され、側面41dにおいて再度全反射されることによって再び所定の軸方向Aに沿った方向に進む。そして、側面41fにおいて全反射され、側面41eにおいて再度全反射されることによって、所定の軸方向Aに沿ってレーザ光出射端41aに入射することとなる。レーザ光出射端41aに達したレーザ光Lの一部はレーザ光出射端41aにおいて所定の軸方向Aに沿って反射し、上記と同様の光路を逆に辿ってレーザ光反射端41bに達する。このようにして、レーザ光Lは、レーザ光出射端41aとレーザ光反射端41bとの間を共振することとなる。

【0055】

本発明による半導体レーザ素子は、上記第1実施形態による屈折率型導波路4に限らず、本実施形態のような形状の屈折率型導波路41を有してもよい。これによって、第1実施形態と同様の効果を得ることができる。また、本実施形態の屈折率型導波路41によれば、レーザ光Lを側面41c~41fにおいて第1実施形態よりも多くの回数全反射させているので、所定の軸方向Aに沿った方向を進むレーザ光L以外のレーザ光を除去する効果が高まり、レーザ光Lの共振モードを単一モードにさらに近づけることができる。

【0056】

(第3の実施の形態)

次に、本発明による半導体レーザ素子アレイ(半導体レーザ素子)の第3実施形態について説明する。図13は、本実施形態による半導体レーザ素子が有する屈折率型導波路4

2を示す平面図である。屈折率型導波路42は、8つの側面42c～42jを備えている。このうち、側面42cと側面42dとが互いに対向しており、側面42eと側面42fとが互いに対向しており、側面42gと側面42hとが互いに対向しており、側面42iと側面42jとが互いに対向している。側面42cの一端はレーザ光反射端42bの一端に接しており、側面42dの一端はレーザ光反射端42bの他端に接している。側面42cの他端は側面42eの一端に繋がっており、側面42dの他端は側面42fの一端に繋がっている。側面42eの他端は側面42gの一端に繋がっており、側面42fの他端は側面42hの一端に繋がっている。側面42gの他端は側面42iの一端に繋がっており、側面42hの他端は側面42jの一端に繋がっている。側面42iの他端はレーザ光出射端42aの一端に接しており、側面42jの他端はレーザ光出射端42aの他端に接している。側面42c～42iは、それぞれ所定の軸方向Aと角度 θ で交差している。側面42cと側面42eとは互いに角度 2θ をなして繋がっており、側面42dと側面42fとは互いに角度 2θ をなして繋がっている。側面42eと側面42gとは互いに角度 2θ をなして繋がっており、側面42fと側面42hとは互いに角度 2θ をなして繋がっている。側面42gと側面42iとは互いに角度 2θ をなして繋がっており、側面42hと側面42jとは互いに角度 2θ をなして繋がっている。本実施形態では、このような形状の屈折率型導波路42が、同様の平面形状を有するリッジ部をp型クラッド層が有することによって実現される。

【0057】

レーザ光反射端42bを所定の軸方向Aに沿って反射したレーザ光Lは、側面42c、42d、42f、42e、42g、42h、42j、42iの順に全反射されることによって、所定の軸方向Aに沿ってレーザ光出射端42aに入射することとなる。レーザ光出射端42aに達したレーザ光Lの一部はレーザ光出射端42aにおいて反射し、上記と同様の光路を逆に辿ってレーザ光反射端42bに達する。このようにして、レーザ光Lは、レーザ光出射端42aとレーザ光反射端42bとの間を共振する。

【0058】

本発明による半導体レーザ素子は、本実施形態のような形状の屈折率型導波路42を有してもよい。これによって、第1実施形態と同様の効果を得ることができる。

【0059】

(第4の実施の形態)

次に、本発明による半導体レーザ素子アレイ（半導体レーザ素子）の第4実施形態について説明する。図14は、本実施形態による半導体レーザ素子が有する屈折率型導波路43を示す平面図である。本実施形態の屈折率型導波路43の形状は、以下の点を除いて上記第1実施形態と同様である。すなわち、本実施形態では、レーザ光反射端43bにおいて所定の軸方向Aに沿って反射したレーザ光Lが、側面43c及び43dのそれぞれにおいて2回ずつ全反射するように、側面43cと側面43dとの間隔（屈折率型導波路43の幅）及びレーザ光出射端43a（光出射面1a）とレーザ光反射端43b（光反射面1b）との間隔（すなわち屈折率型導波路43の長さ）が設定されている。

【0060】

レーザ光反射端43bを所定の軸方向Aに沿って反射したレーザ光Lは、側面43cにおいて全反射され、側面43dにおいて再度全反射されることによって再び所定の軸方向Aに沿った方向に進む。そして、再び側面43cにおいて全反射され、側面43dにおいて全反射されることによって、所定の軸方向Aに沿ってレーザ光出射端43aに入射することとなる。レーザ光Lの一部はレーザ光出射端43aにおいて所定の軸方向Aに沿って反射し、上記と同様の光路を逆に辿ってレーザ光反射端43bに達する。このようにして、レーザ光Lは、レーザ光出射端43aとレーザ光反射端43bとの間を共振する。

【0061】

本発明による半導体レーザ素子は、本実施形態のような形状の屈折率型導波路43を有してもよい。これによって、第1実施形態と同様の効果を得ることができる。なお、屈折率型導波路の側面においてレーザ光を全反射させる回数は、第1実施形態（各側面におい

て一回ずつ)、及び本実施形態(各側面において二回ずつ)に限らず、任意の回数に設定することができる。また、本実施形態のように屈折率型導波路の側面における反射回数を多くするためには、屈折率型導波路の長さを長くするとよい。屈折率型導波路の長さを長く設定することにより、半導体レーザ素子からの熱放出を活発にして大出力化、長寿命化を図ることができる。

【0062】

(第5の実施の形態)

次に、本発明による半導体レーザ素子アレイ(半導体レーザ素子)の第5実施形態について説明する。図15は、本実施形態による半導体レーザ素子が有する屈折率型導波路44を示す平面図である。本実施形態の屈折率型導波路44の平面形状は、以下の点を除いて第1実施形態による屈折率型導波路4と同様である。すなわち、本実施形態の屈折率型導波路44は、レーザ光出射端44a側(すなわち光出射面1a側)の端部における側面44g及び44h、並びにレーザ光反射端44b側(すなわち光反射面1b側)の端部における側面44c及び44dが、所定の軸方向Aに沿って形成されている。

【0063】

具体的には、屈折率型導波路44は、6つの側面44c～44hを備えている。このうち、側面44cと側面44dとが互いに対向しており、側面44eと側面44fとが互いに対向しており、側面44gと側面44hとが互いに対向している。側面44eの一端はレーザ光反射端44bの一端に接しており、側面44fの一端はレーザ光反射端44bの他端に接している。側面44eの他端は側面44cの一端に繋がっており、側面44fの他端は側面44dの一端に繋がっている。側面44cの他端は側面44gの一端に繋がっており、側面44dの他端は側面44hの一端に繋がっている。側面44gの他端はレーザ光出射端44aの一端に接しており、側面44hの他端はレーザ光出射端44aの他端に接している。側面44c及び44dは、それぞれ所定の軸方向Aと角度 θ で交差している。また、側面44e～44hは、それぞれ所定の軸方向Aに沿って延びている。側面44eと側面44cとは互いに角度 θ をなして繋がっており、側面44fと側面44dとは互いに角度 θ をなして繋がっている。側面44cと側面44gとは互いに角度 θ をなして繋がっており、側面44dと側面44hとは互いに角度 θ をなして繋がっている。本実施形態では、このような形状の屈折率型導波路44が、同様の平面形状を有するリッジ部をp型クラッド層が有することによって実現される。

【0064】

レーザ光反射端44bを所定の軸方向Aに沿って反射したレーザ光Lは、側面44cにおいて全反射され、側面44dにおいて再度全反射されることによって、所定の軸方向Aに沿ってレーザ光出射端44aに入射することとなる。レーザ光Lの一部はレーザ光出射端44aにおいて所定の軸方向Aに沿って反射し、上記と同様の光路を逆に辿ってレーザ光反射端44bに達する。このようにして、レーザ光Lは、レーザ光出射端44aとレーザ光反射端44bとの間を共振することとなる。

【0065】

本発明による半導体レーザ素子は、本実施形態のような形状の屈折率型導波路44を有してもよい。これによって、第1実施形態と同様の効果を得ることができる。また、本実施形態の屈折率型導波路44では、屈折率型導波路44の両端部の側面44e～44hが所定の軸方向Aに沿って形成されているので、レーザ光出射端44a及びレーザ光反射端44bにおいて所定の軸方向Aと異なる方向へ出射されるレーザ光L(サイドモード光)を抑制することができる。従って、本実施形態の屈折率型導波路44によれば、レーザ光Lの出射角をより小さくすることができる。なお、所定の軸方向に沿った側面は、屈折率型導波路のレーザ光出射端44a側(すなわち光出射面1a側)の端部のみに形成されてもよく、屈折率型導波路のレーザ光反射端44b側(すなわち光反射面1b側)の端部のみに形成されてもよい。

【図面の簡単な説明】

【0066】

【図 1】本発明による半導体レーザ素子アレイの第 1 実施形態の構成を示す概略斜視図である。

【図 2】図 1 に示した半導体レーザ素子アレイの I-I 断面を示す拡大断面図である。

【図 3】p 型クラッド層 17 を含む積層体 8 の斜視図である。

【図 4】(a) 積層体の平面図である。(b) (a) に示した積層体の II-II 断面を示す断面図である。

【図 5】各製造工程における半導体レーザ素子アレイの拡大断面図を示している。

【図 6】リッジ部に対応して形成される屈折率型導波路の形状を示す平面図である。

【図 7】屈折率型導波路の側面に様々な入射角 θ_i で入射するレーザ光について説明するための図である。

【図 8】角 θ の大きさが許容される範囲を説明するためのグラフである。

【図 9】(a) 本実施例による半導体レーザ素子の電流-光出力特性を示すグラフである。(b) 半導体レーザ素子のレーザ光出射端から出射されたレーザ光の水平方向の遠視野像を示すグラフである。

【図 10】(a) 従来の共振器の電流-光出力特性を示すグラフである。(b) 従来の共振器から出射されたレーザ光の水平方向の遠視野像を示すグラフである。

【図 11】(a) 半導体レーザ素子アレイの電流-光出力特性を示すグラフである。(b) 本実施例に係る半導体レーザ素子アレイが備える各半導体レーザ素子のレーザ光出射端から出射されたレーザ光の水平方向の遠視野像を示すグラフである。

【図 12】第 2 実施形態による半導体レーザ素子が有する屈折率型導波路を示す平面図である。

【図 13】第 3 実施形態による半導体レーザ素子が有する屈折率型導波路を示す平面図である。

【図 14】第 4 実施形態による半導体レーザ素子が有する屈折率型導波路を示す平面図である。

【図 15】第 5 実施形態による半導体レーザ素子が有する屈折率型導波路を示す平面図である。

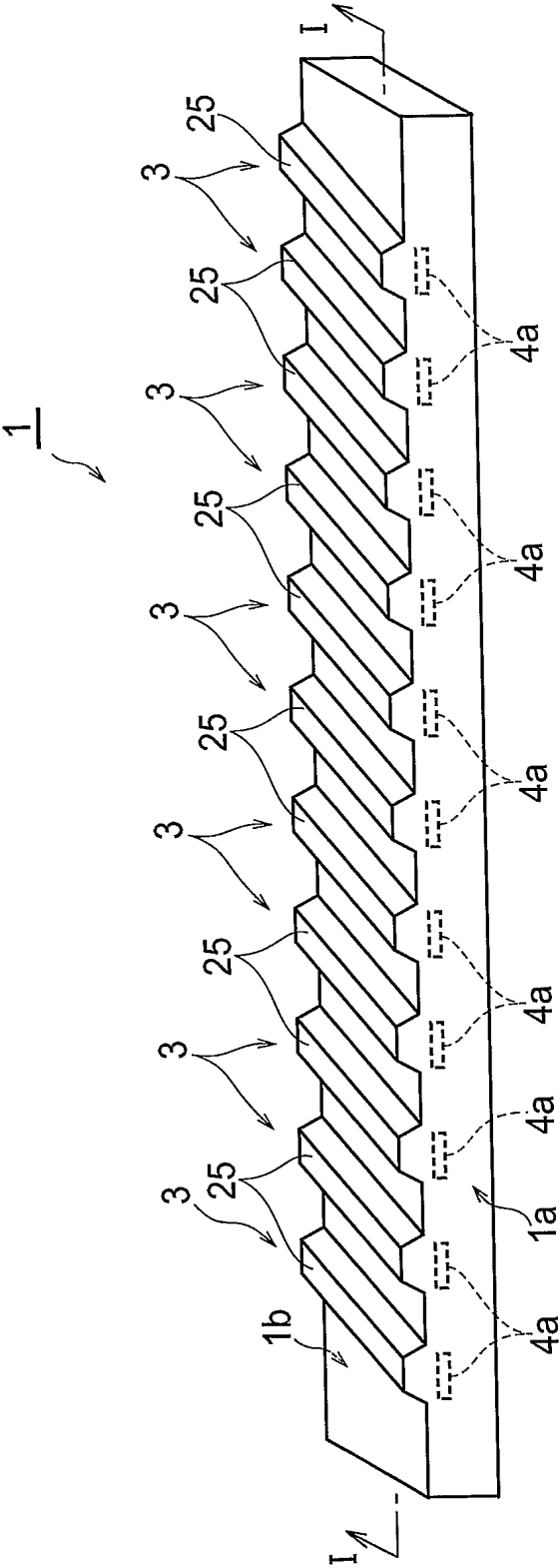
【図 16】(a) 従来の共振器の構成を示す平面図である。(b) 図 16 (a) の II-I-III 断面及び IV-IV 断面における屈折率分布を示す図である。

【符号の説明】

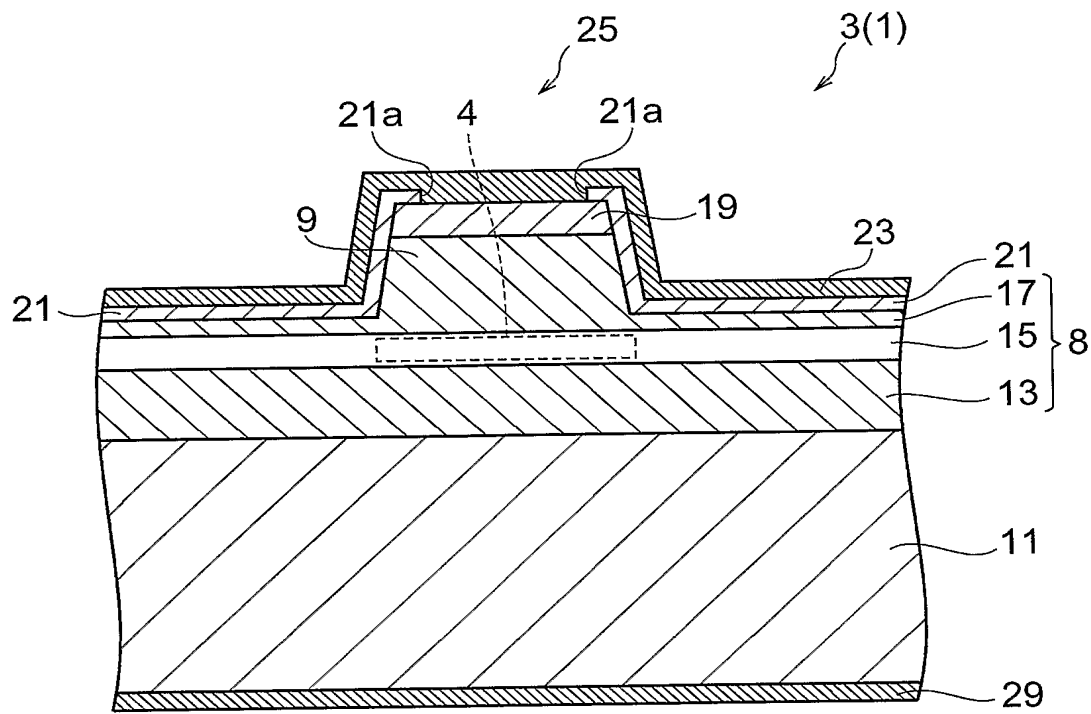
【0067】

1…半導体レーザ素子アレイ、1a…光出射面、1b…光反射面、3…半導体レーザ素子、4、41～44…屈折率型導波路、4a、41a～44a…レーザ光出射端、4b、41b～44b…レーザ光反射端、4c、4d、41c～41f、42c～42j、43c、43d、44c～44h…側面、8…積層体、9…リッジ部、9a…第 1 端面、9b…第 2 端面、9c、9d…側面、10…薄肉領域、11…基板、13…n 型クラッド層、15…活性層、17…p 型クラッド層、19…キャップ層、21…絶縁層、21a…開口部、23…p 側電極層、25…凸部、29…n 側電極層、51…保護マスク。

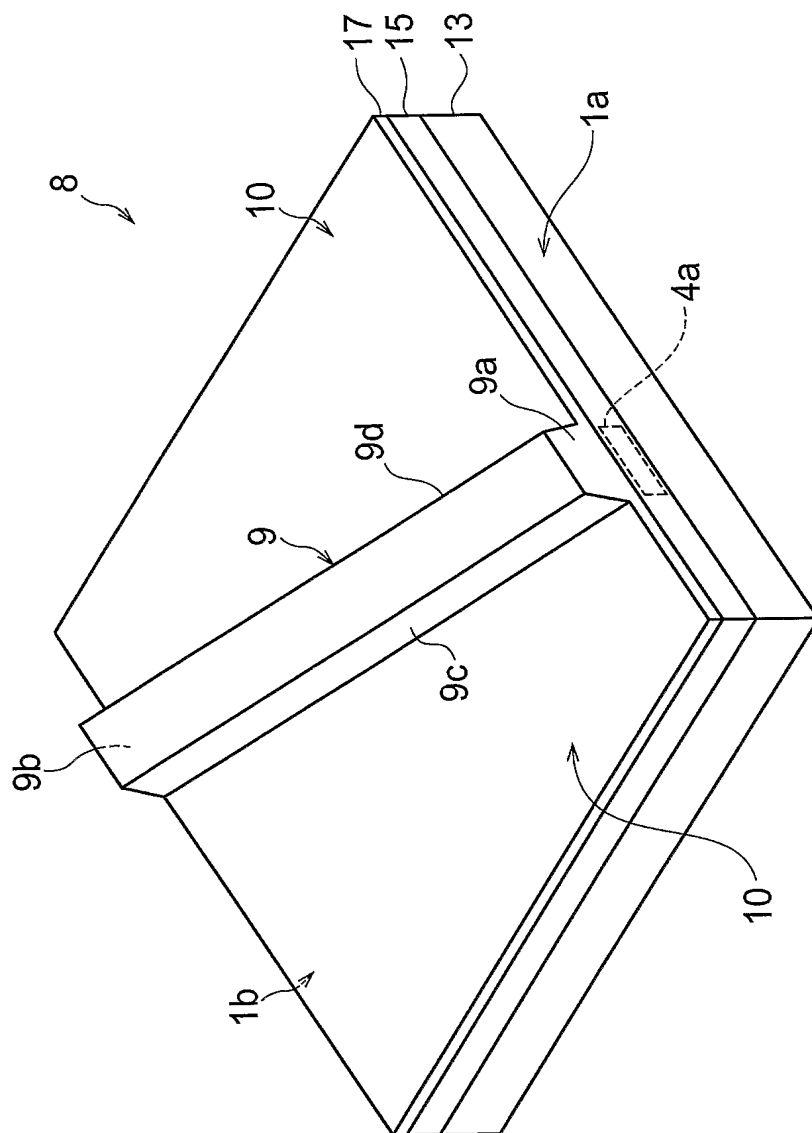
【書類名】 図面
【図 1】



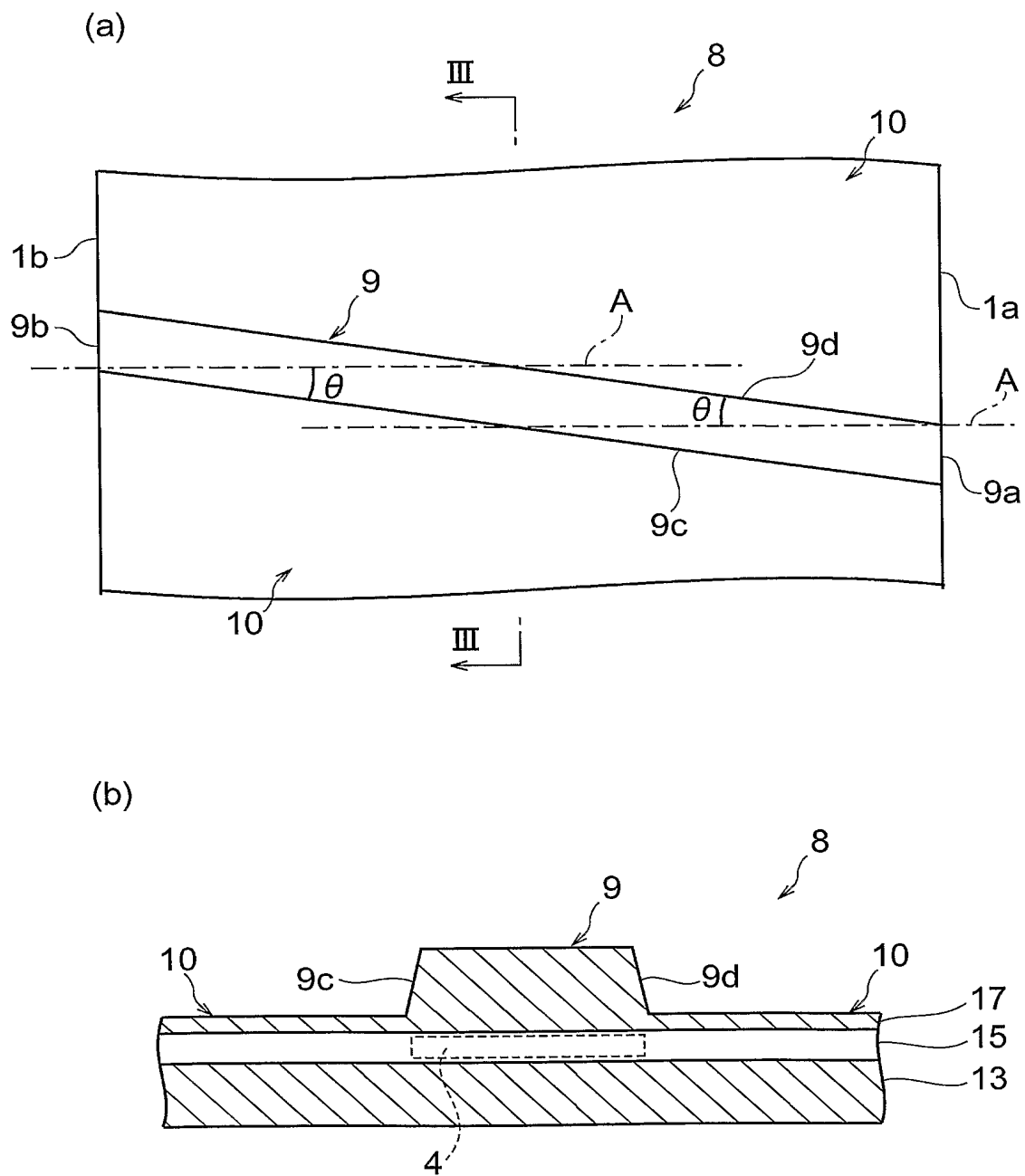
【図 2】



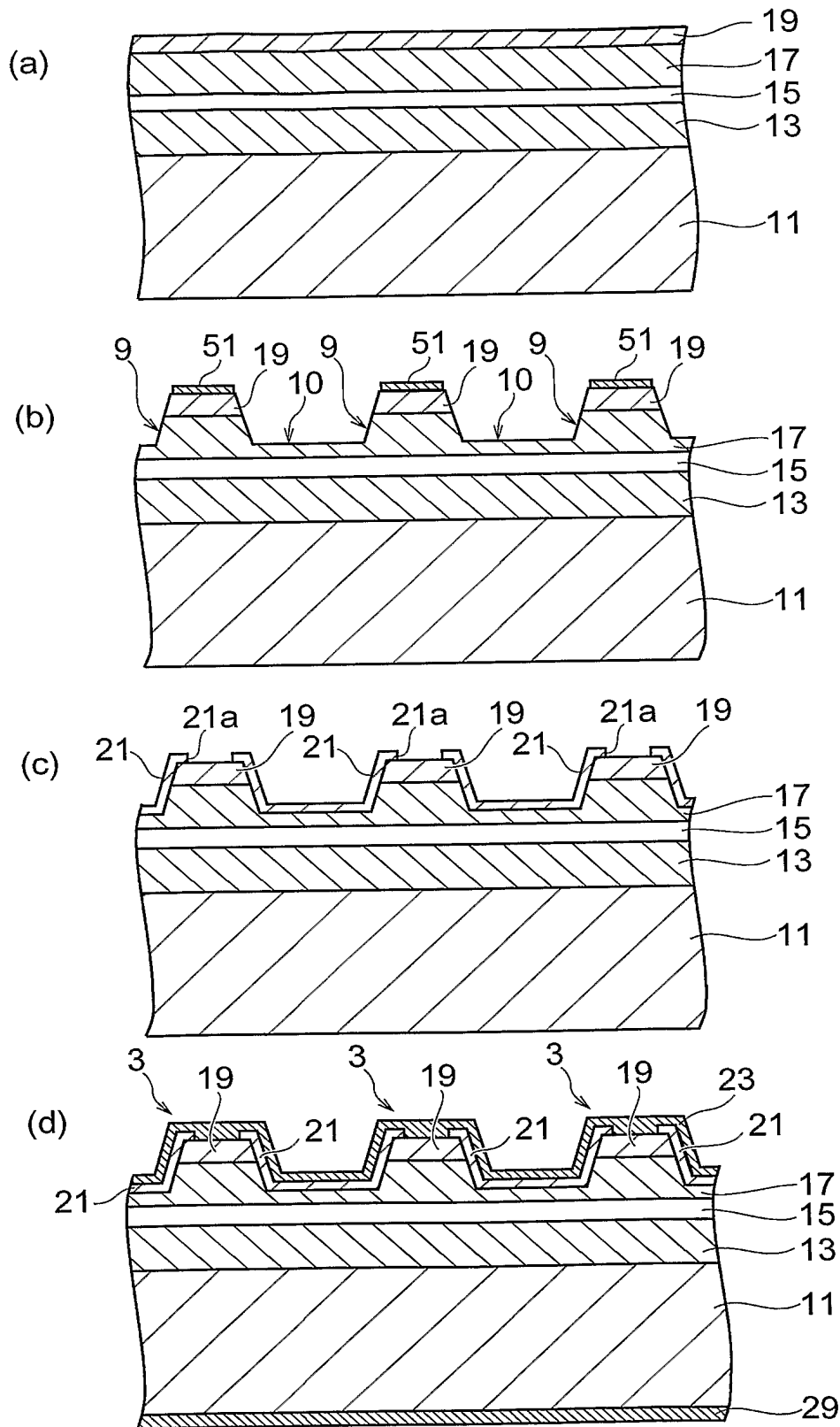
【図 3】



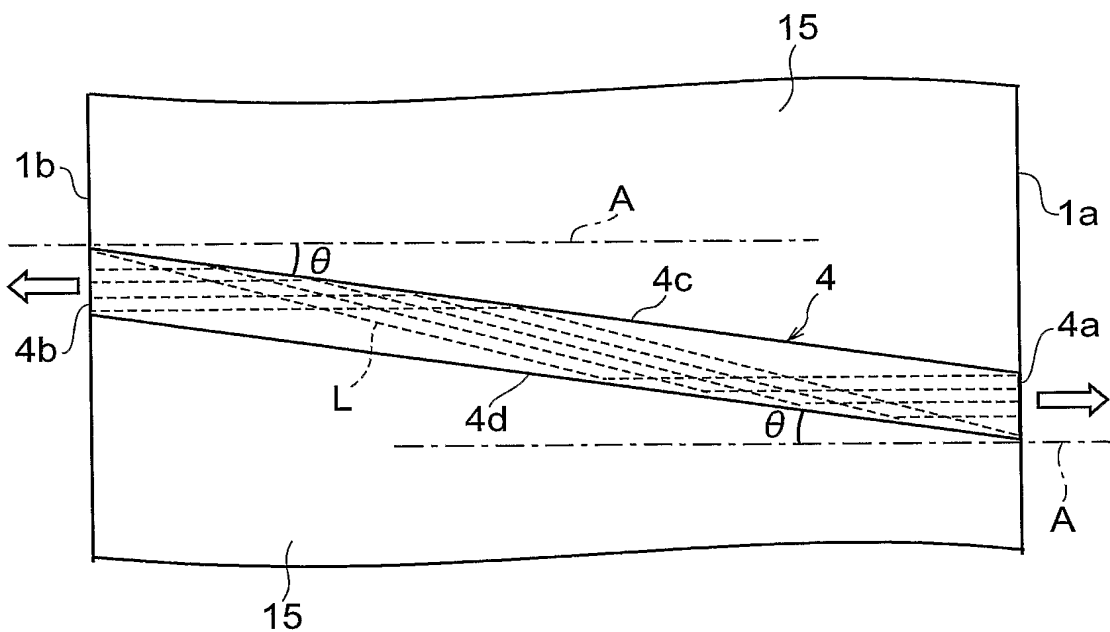
【図 4】



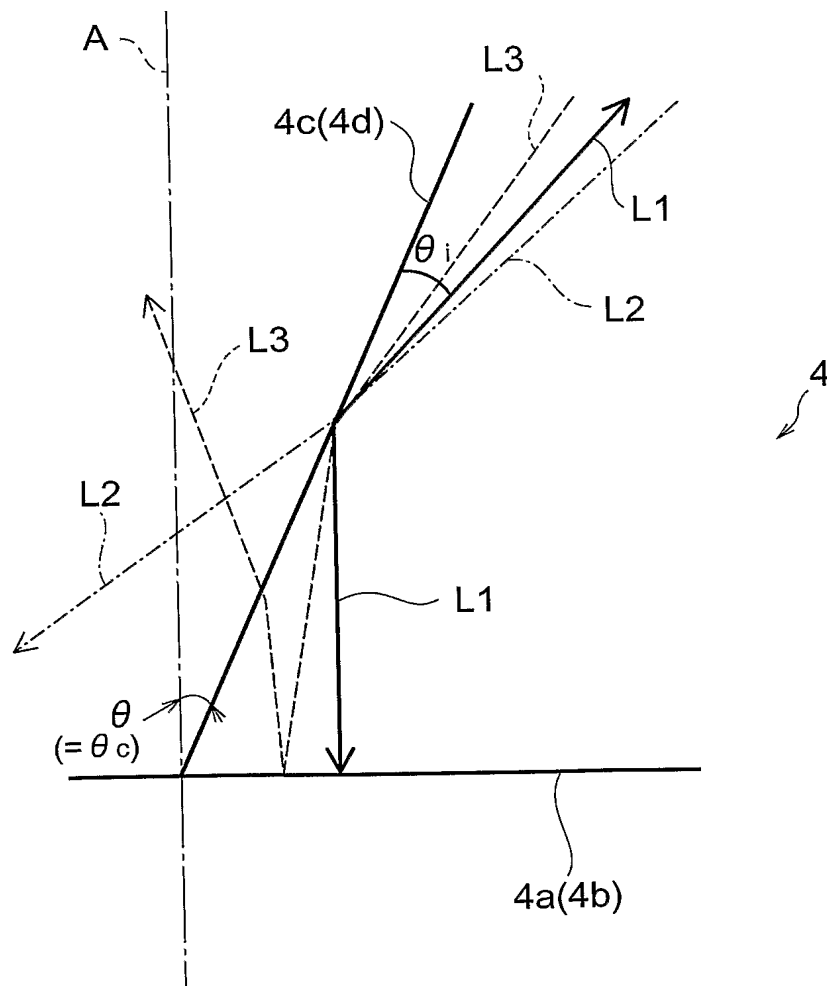
【図 5】



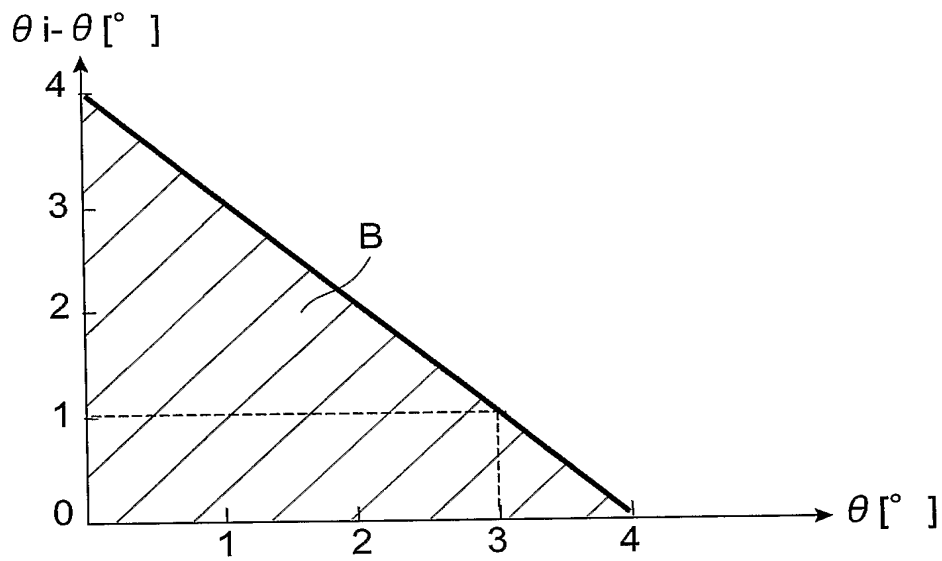
【図 6】



【图 7】

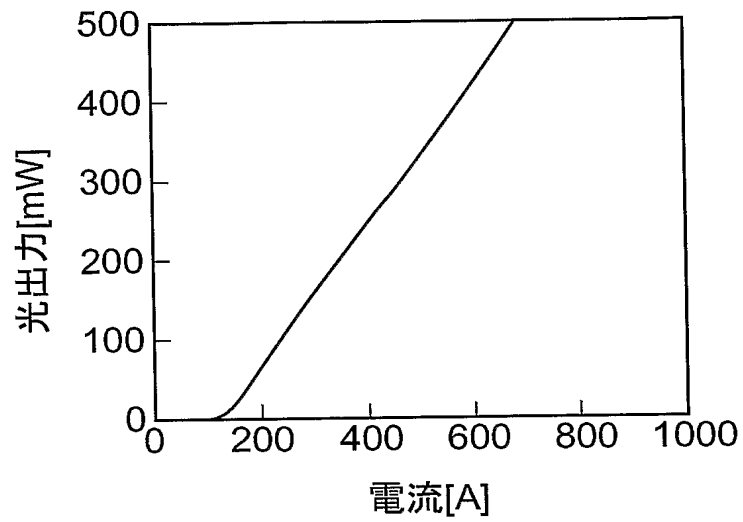


【図 8】

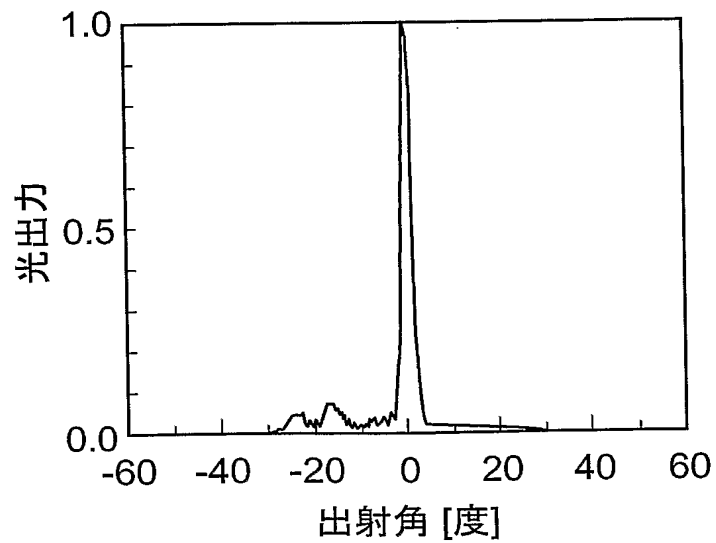


【図 9】

(a)

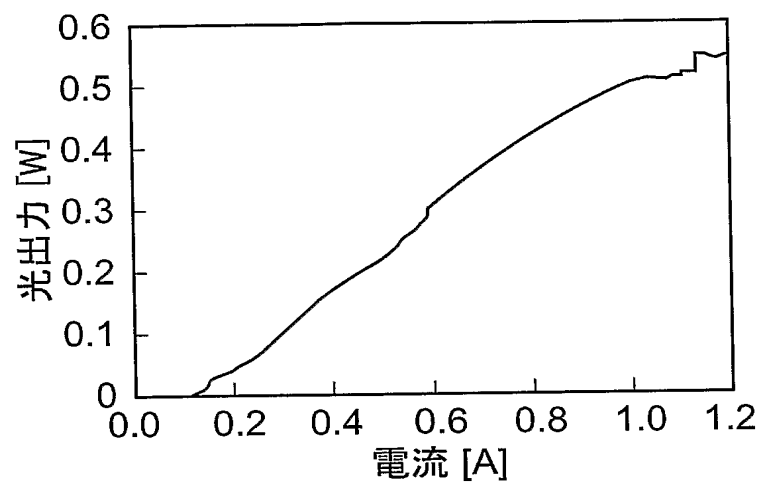


(b)

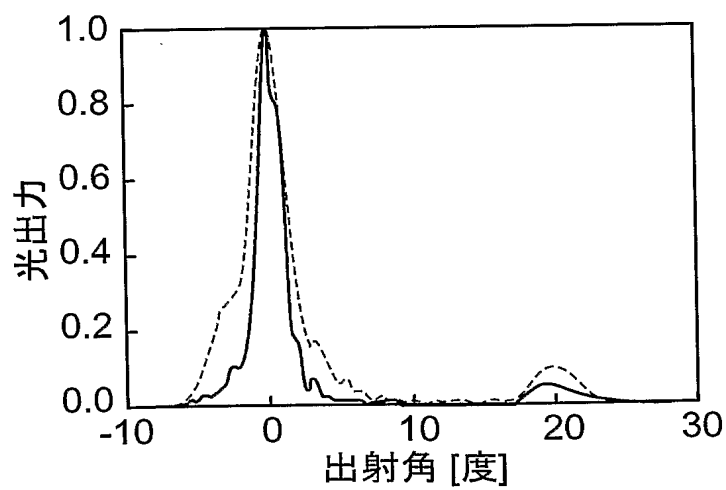


【図 10】

(a)

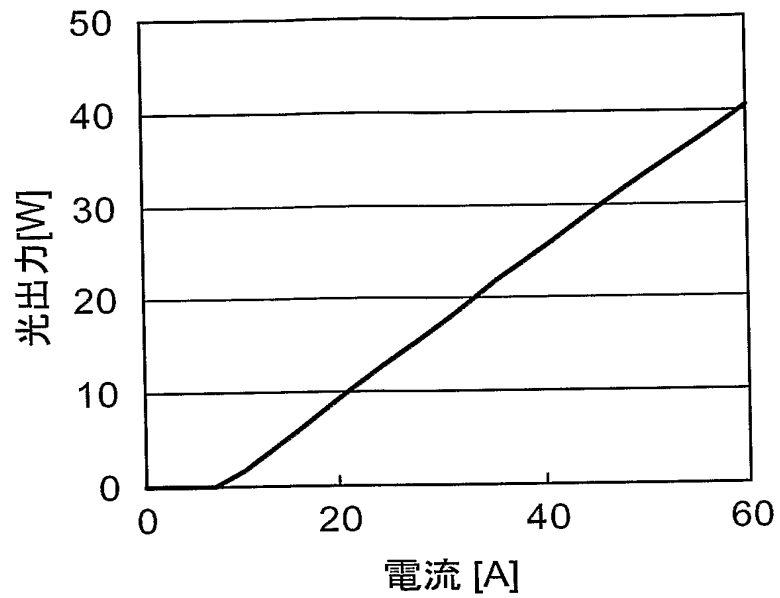


(b)

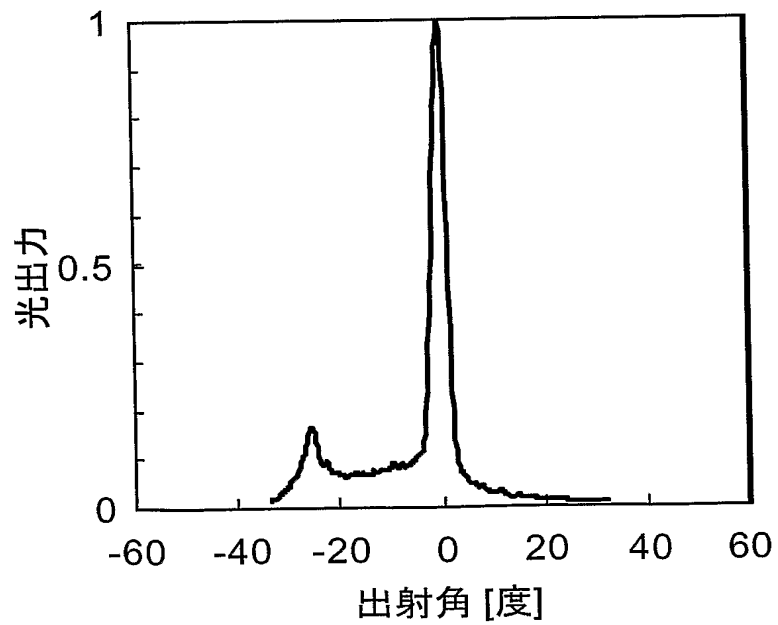


【図 11】

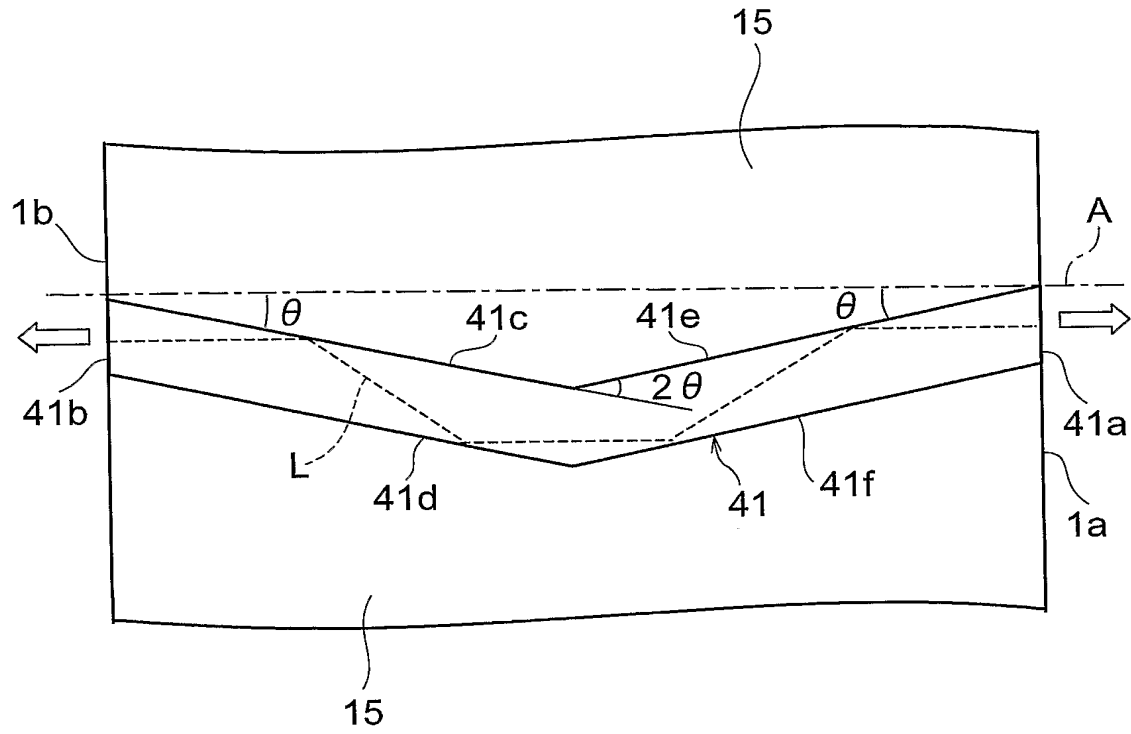
(a)



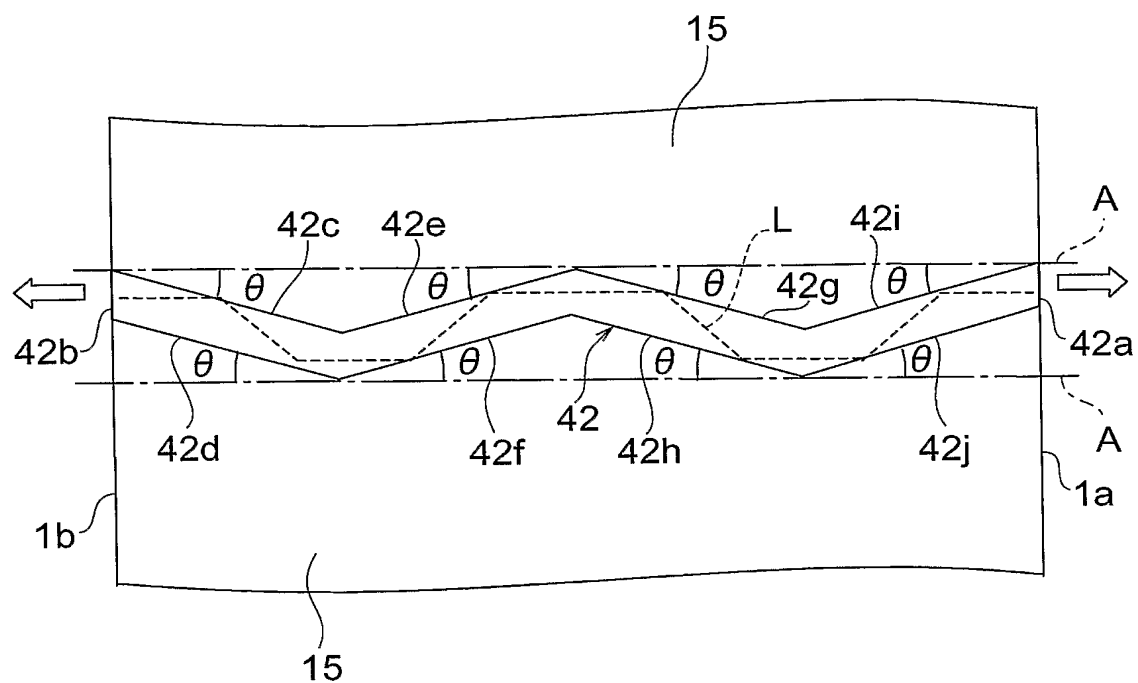
(b)



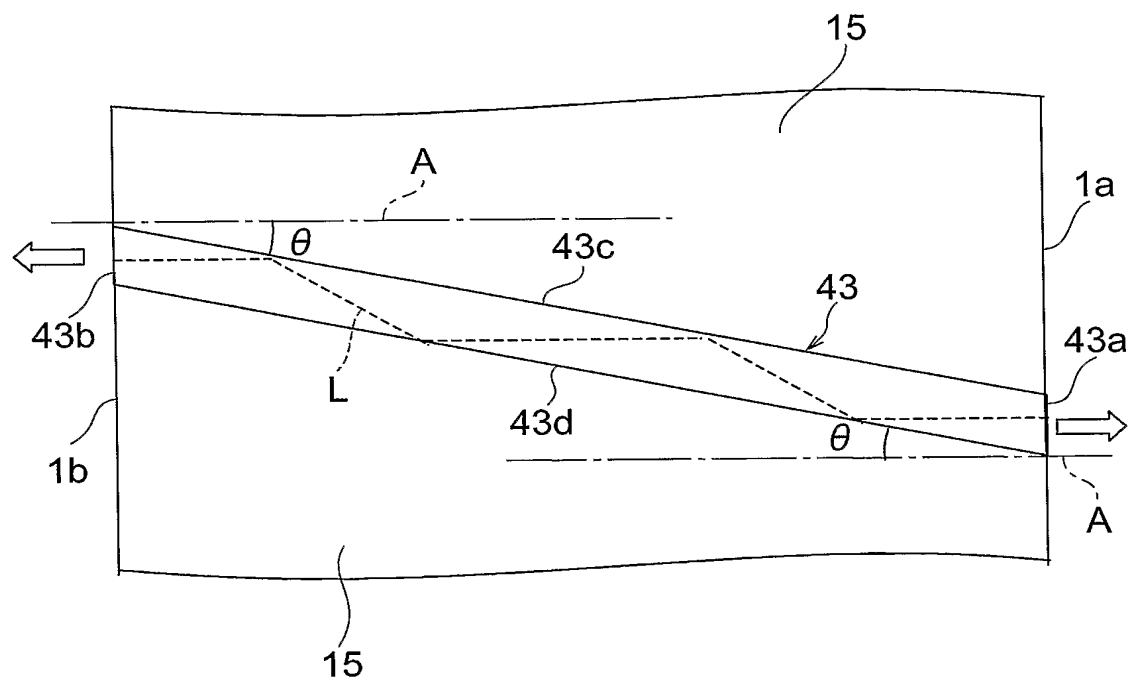
【図 12】



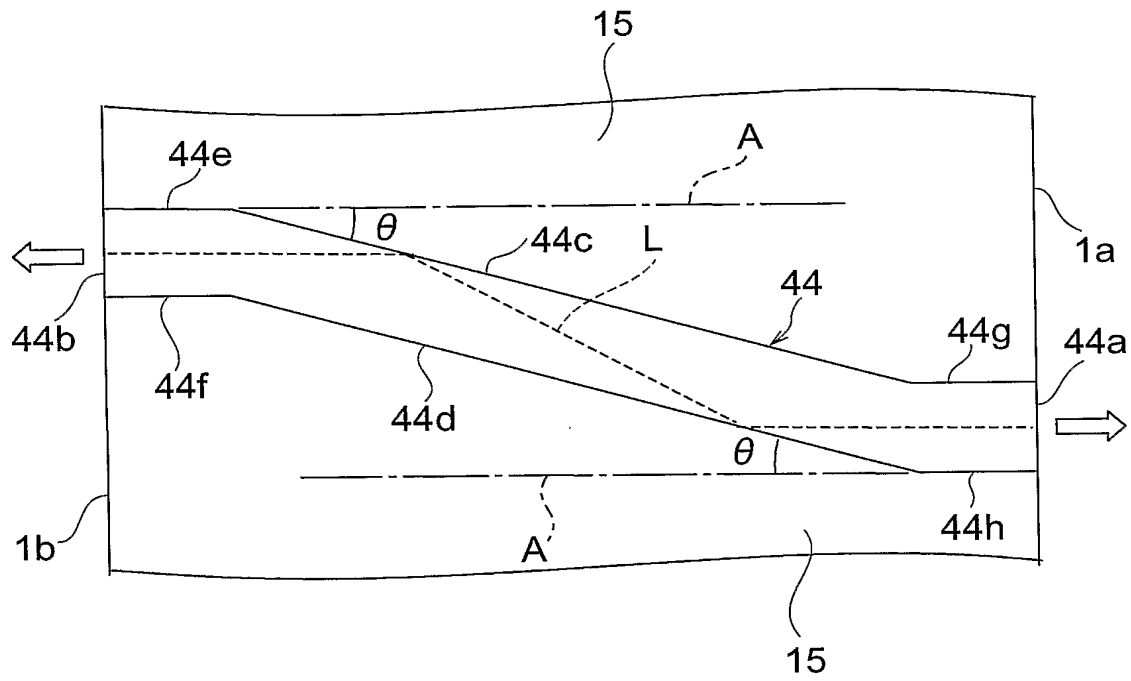
【図 13】



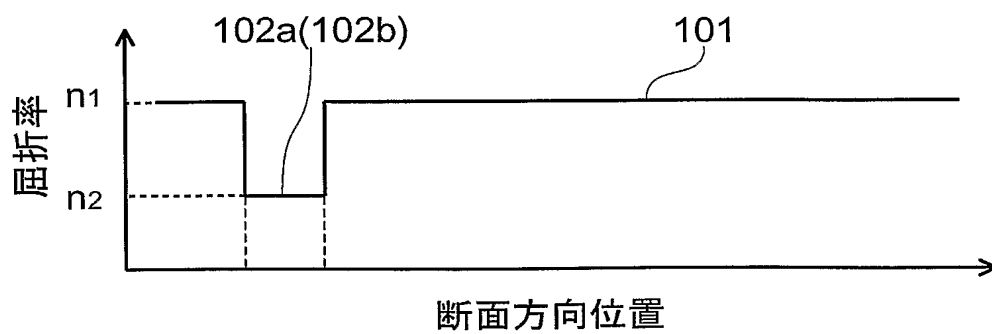
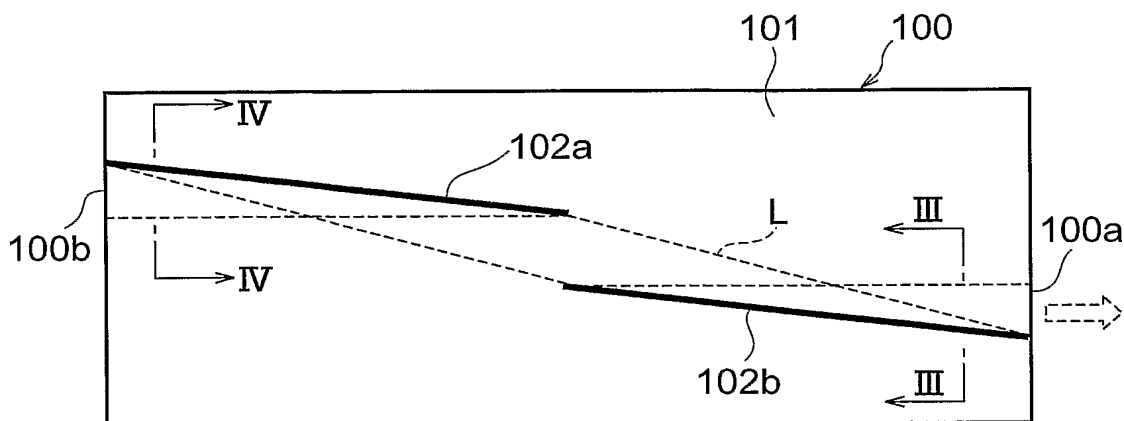
【図 14】



【図 15】



【図 16】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 比較的大きな強度の空間横単一モードレーザ光を出射可能であって、レーザ光の出射角が小さく、構成が単純であり、且つ効率のよい半導体レーザ素子及び半導体レーザ素子アレイを提供する。

【解決手段】 半導体レーザ素子 3 は、n 型クラッド層 13 と、活性層 15 と、p 型クラッド層 17 とを備える。p 型クラッド層 17 は、活性層 15 に屈折率型導波路 4 を形成するリッジ部 9 を有する。屈折率型導波路 4 は、一対の側面 4c 及び 4d を有する。一対の側面 4c 及び 4d は、該側面 4c 及び 4d における臨界角 θ_c に基づく角度 θ で所定の軸方向 A と交差している。屈折率型導波路 4 内を共振するレーザ光 L の光路は、側面 4c 及び 4d において全反射される光路のみに限定される。従って、レーザ光 L が空間横単一モードとなり、さらに導波路幅を広くすることができるため出射角を小さくできる。

【選択図】 図 6

特願 2 0 0 4 - 0 6 1 2 1 6

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [0 0 0 2 3 6 4 3 6]

1. 変更年月日 1 9 9 0 年 8 月 1 0 日

[変更理由] 新規登録

住 所 静岡県浜松市市野町 1 1 2 6 番地の 1
氏 名 浜松ホトニクス株式会社